剣持 貴弘 27

吉備国際大学 政策マネジメント学部研究紀要 第2号,27-32,2006

フラクタル幾何学のスパッタリング現象への応用

剣持 貴弘

Application of the fractal topography to sputtering

Takahiro KENMOTSU

1. ACAT コード

モンテカルロ・シミュレーションコード ACAT [1] は岡山理科大学の山村によって荷電粒子と固 体との相互作用を解析するために開発され、現在ま でにスパッタリング収量、入射粒子の反射率などの データ構築、イオン注入法による固体中の分布など 広い分野で活用されてきた。

これまでの ACAT コードは固体表面をほぼ完全 な平面として設定し解析を行ってきた。しかしなが ら、実際のターゲット表面は原子スケールでみると 凹凸があり、スパッタリング収量に関しては、斜め から粒子が入射される場合に、その影響が大きいこ とが実験的に知られている[2]。

本研究では、シミュレーション・コードをより現 実的な条件で解析が行えるようにフラクタル曲面を 用いて原子スケールの凹凸を生成し、スパッタリン グ収量の入射角依存性を解析した。

固体表面の微視的な凹凸を考慮したシミュレー ションを行うにあたって、従来のACATコードか ら改良した点は、3つあり、1つはフーリエ・フィ ルタリング法[3]を採用したことである。2つ目 は従来のACATコードが固体表面の標的原子から の引力を平板ポテンシャルで評価していたのに対し て、多体ポテンシャル(many-body tight-binding potential) [4]を用いて評価したことである。最後 に、ターゲットと粒子の入射角に関して、ターゲッ トは周期境界条件を設け、本研究では横方向に100 ユニット・セルの幅を周期とした。また、入射角は 偏角を初期条件で与え、方位角は擬似乱数を用いて 入射粒子ごとにランダムに決定した。完全平面を想 定している場合は、方位角をランダムにとる必要は ないが、表面の凹凸を考慮した場合は、解析結果に 入射粒子の方位角依存性を反映しないように、入射 粒子を方位角に関してランダムに入射させる必要が ある。以下に、ACAT コードのモデルと3つの改良 点の簡単な説明をする。

1-1. ACAT モデル

ACAT コードは原子の衝突過程を運動粒子と標的 原子の2つの粒子のみを考慮するという2体間衝突 近似モデルを採用し、ターゲットはターゲットの密 度N (g/cm³) から決められる格子定数 $R_0 = N^{-1/3}$ を1辺とするユニット・セルに分割し、そのセルの 中にランダムにターゲット原子を発生させることで

吉備国際大学 政策マネジメント学部 環境リスクマネジメント学科

^{〒716-8508} 岡山県高梁市伊賀町8

Department of Environmental Risk Management, School of Policy Management, Kibi International University

^{8,} Igamachi, Takahashi, Okayama, 716-8508, Japan

アモルファス・ターゲットを生成している。図1-1-1に ACAT コードの概念図を示す。

固体表面の取り扱いについては、ユニットセル・ モデルを採用していることにより、標準的な ACAT コードによる解析には格子定数の半分程度の凹凸が 考慮されていることになる。図1-1-1を表面近 傍に関して詳しく示したのが図1-1-2である。

また、図1-1-3に2体間衝突近似モデルを示 す。図1-1-3より、pは衝突係数、Eは入射エ ネルギー、入射粒子の質量 M_1 、ターゲット原子の 質量 M_2 、 Θ は重心系の散乱角、 Φ は実験室系の反 跳角、Tはターゲット原子の反跳エネルギーである。

ここで、原子衝突を弾性散乱と仮定し、入射粒子 とターゲット原子の間に働くポテンシャルを*V*(*r*) とすると重心系の散乱角 Θ は次式で与えられる。

$$\Theta = \pi - 2p \int_0^\infty dr \left[r^2 g(r) \right]^{-1}.$$

ここに、

$$g(r) = \left[1 - \frac{p^2}{r^2} - \frac{v(r)}{E_r}\right]^{\frac{1}{2}},$$

r は原子間距離で、特に r_0 は $g(r_0) = 0$ を満たす近 日点である。また、 $E_r = \frac{A}{(A+1)}E$ は相対エネルギー であり、 $A = M_2/M_1$ である。

重心系の散乱角 Θ から、反跳エネルギーTと実 験室系の散乱角 $\hat{\theta}$ が次式で与えられる。





$$T = \frac{4A}{\left(A+1\right)^2} E \sin^2\left(\frac{\Theta}{2}\right),$$

$$\hat{\theta} = \tan^{-1} \frac{A \sin \Theta}{1 + A \cos \Theta}.$$

また、散乱後の入射粒子とターゲット原子の位置 X'1、X'2 は衝突前のそれぞれの位置X1、X2 と ΔX1、ΔX2 を用いて、

$$X'_1 = X_1 - \triangle X_1$$

$$X'_2 = X_2 + \Delta X_2$$

で決められる。ここで、 ΔX_1 、 ΔX_2 は以下の式で与 えられる。

$$\Delta X_{1} = \frac{2\tau + (A - 1)Ptan \frac{\Theta}{2}}{(1 + A)},$$

$$\Delta X_{2} = ptan \frac{\Theta}{2} - \Delta X_{1}.$$

 τ は time integral であり、次式で定義される。

$$\tau = (r_0 - p^2)^{\frac{1}{2}} - \int dr \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - V(r)/E_r - p^2/r^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - p^2/r^2}} \right\}.$$

表面の凹凸によるスパッタリング収量への影響を 評価するために、格子定数の半分程度の粗さを考慮 することができる標準的な ACAT コードと表面の 標的原子の位置を深さ0の完全平面にした場合のシ ミュレーション結果を図1-1-4に示す。図よ り、入射角が50度くらいでは、どちらのモデルの解 析結果も、ほぼ同じであるか、それ以上の角度にな ると、完全水平面モデルの方がスパッタリング収量 が大きくなる。また、スパッタリング収量の入射角 依存性に関しては表面の凹凸が考慮されているモデ ルの方が依存性が少ないことが分かる。また、2つ のモデルにおける入射粒子の反射率を解析した結果 が図1-1-5である。図より、表面の凹凸によっ て入射粒子の反射率が完全平面に比べて大きくなる ことが分かる。この傾向は入射角が大きくなるにつ れて顕著になり、そのため表面の凹凸がある方がス パッタリング収量の入射角依存性が完全平面の場合 に比べて少なくなることが考えられる。

1-2.表面凹凸の生成モデル

前節においは、表面の凹凸のスパッタリング収量 への影響を評価するために通常の ACAT コードと 完全平面の場合との違いの解析を行ったが、本研究 では、より詳細に表面の凹凸による影響を調べるた めに、フラクタル幾何学(フーリエ・フィルタリン グ法)を採用した。フーリエ・フィルタリング法で は、以下のようにして原子スケールの固体表面の粗 さ(凸凹)を生成する。

まず、水平位置 r = xi + yj に対する高さ z は2 次元離散フーリエ逆変換から与えられる。

 $z(r) = \sum_{kx=0} \sum_{ky=0} \{A(k)\cos(k \cdot r) + B(k)\sin(k \cdot r)\},\$

ここで、 $k = k_x i + k_y j$ は波数ベクトル、A(k)、 B(k)はフーリエ係数の実部と虚部である。A(k)及 びB(k)はスペクトル密度S(k)が次式を満たす実 乱数として抽出される。



図1-2-1 フラクタル曲面 (2.1次元)



図1-2-2 フラクタル曲面 (2.5次元)

$$A^{2}(k) + B^{2}(k) = S(k) \infty \left(\left| k \right|^{2} \right)^{-\beta} = \left(k_{x}^{2} + k_{y}^{2} \right)^{-\beta},$$

ここで、 $\beta = 4 - D$ で $D(2 \le D \le 3)$ はフラクタル 次元である。図1 - 2 - 1、1 - 2 - 2にフーリ エ・フィルタリング法によって生成したフラクタル 曲面を示す。

図1-2-1、1-2-2より、フラクタル次元 が大きいほど表面の複雑さが増す。特に、凹凸のな い完全な平面はフラクタル次元が2になり、空間を 覆いつくすほど表面形状が複雑な表面はフラクタル 次元が3に近い値をとる。

1-3. 多体ポテンシャル

本研究において、表面近傍の原子に作用するエネ ルギー *Es* を評価するために以下に示す多体ポテン シャルを採用した。

$$E_{s} = \sum (E_{i}^{R} + E_{i}^{B}),$$

ここで、 $E_{i}^{R} \geq \frac{B}{i}$ は *i* 番目の原子の斥力項と引力
項である。 $E_{i}^{R} \geq \frac{B}{i}$ は次式で与えられる。

 $E_i^R = \sum U_{ij}(r_{ij}),$

$$\begin{split} U_{ij}(r_{ij}) &= Aexp(-p(r_{ij/r_0}-1)), \\ E_i^B &= -\left(\left(\sum_{j\neq i} \phi(r_{ij})\right)\right)^{\frac{1}{2}}, \end{split}$$

$$\phi(r_{ij}) = \xi^2 exp \left(-2q \left(r_{ij/r_0} - 1\right)\right),$$

ここで、*r_{ij}*は*i*番目の原子とj番目の原子の間の距離。*A、ξ、p、q、r*oはターゲットの種類によって 決められるパラーメタで、本研究で取り扱うモリブ デン(*Mo*)に対しては、それぞれ、0.2043、2.5097、 10.0154、2.0511、2.7253 [4]が与えられてい る。

1-4. 境界条件と方位角

最後の3つ目は、粒子の入射に関して、ターゲッ トに周期境界条件を設け、本研究では横方向に関し て100ユニット・セルの幅を周期とした。周期境界 条件の概念図を図1-4-1に示す。また、入射角 度に関しては、生成されたフラクタル表面の構造が シミュレーション結果に影響しないように偏角は初 期条件で与えるが、方位角は擬似乱数を使って入射 粒子ごとにランダムに決める方法をとった。

2. スパッタリング収量の解析結果

図2-1に2keVの重水素イオンをモリブデンに 照射した場合の規格化されたスパッタリング収量に 関する入射角依存性を示す。規格化は垂直入射のス パッタリング収量を用いて行った。実験データ [5]に比べて、標準的な ACAT コードの計算結



図1-1-4 100eV のタングステンイオンをタングス テン(W) ターゲットに照射した場合のスパッタリング 収量の入射角依存性



図1-1-5 100eV のタングステンイオンをタングス テン(W) ターゲットに照射した場合の反射率の入射角 依存性





図2-1 2keVのDイオンをモリブデン (Mo) ター ゲットに照射した場合のスパッタリング収量の入射角依存 性に関する実験データ [5] と ACAT コードの解析結果



図 2 - 2 2 keV の D イオンをモリブデン (Mo) ター ゲットに照射した場合(垂直入射)の反射率とフラクタル次 元の関係

果がどの入射角度においても大きいのがわかる。特 に、入射角が50度を超えるとこの違いは大きくな る。これは、図1-1-4で示した反射率に関係し て表面の凹凸がある場合の方がより多くの入射粒子 が反射しスパッタリングに寄与しないためと考えら れる。これに対してフラクタル次元を2.1にした場 合、実験結果とよい一致がみられる。図2-1の2 種類のACATコードの解析条件の違いは固体表面 の粗さの違いのみであるが(標準的なACATコー ドは格子定数の半分程度の凹凸を考慮することがで きる)、表面の粗さがスパッタリング収量に影響 し、またこの実験に用いられたターゲットの表面が フラクタル次元は2.1に近い形状をしていたと考え られる。

実験データとフラクタル ACAT コードの計算結 果の比較において、入射角度が80°をこえるような 斜入射の場合、実験データが減少するのに対して、 シミュレーション結果が増加している。この傾向の 違いは、現在のところ今回採用したフラクタル曲面 生成モデルが影響していると考えている。今後は、 中点変位法などの別のフラクタル曲面生成モデルを 用いて、モデル依存性を調べる必要があると思われ る。

また、2つの ACAT コードシミュレーションに 関して、参考文献[6]で規格化していないスパッ タリング収量自体を比較したものを示しているが、 表面の凹凸を考慮した方が入射角全般にわたってス パッタリング収量が小さい。これは、スパッタリン グ収量がターゲットの密度に比例しているためであ ると考えられる。つまり、固体表面の凹凸がある と、スパッタリングへの寄与が大きい表面近傍の ターゲットの密度が、固体内部より小さくなりス パッタリング粒子となりうるターゲット原子数が減 少するためである。

最後に図2-2に入射粒子の反射率とフラクタル 次元の関係を示すが、反射率にフラクタル次元依存 性はあまりみられない。このことに関しても、前述 のスパッタリング収量同様、フラクタル曲面生成モ デル依存性を検証する必要があるように思われる。

3. まとめ

本研究において、固体表面の凹凸がスパッタリン グ現象にどのように寄与するかを評価するために、 フーリエ・フィルタリング法によってフラクタル曲 面を生成しモンテカルロ・シミュレーションコード ACAT に取り入れた。このフラクタルモデルにおい て、表面の凹凸の度合いはフラクタル次元で決めら れ、今回の解析では実験データに合うように2.1に 決められた。

また、固体表面近傍の原子からの相互作用エネル ギーとして、多体効果を考慮できる many-body tight-binding potential を採用し、従来の ACAT コー ドが引力項のみを考慮していたのに対し、引力、斥 力のどちらも評価できるように改良した。

本研究では、2keVD⁺→Moの2つのスパッタリ ング収量に関する実験データを基に解析を行った。 従来のACATコードの解析結果は実験データより 大きい値を示す。このことから、実験に用いたター ゲット表面の凹凸が格子定数の半分以上であった可 能性が考えられる。スパッタリング実験に関して、 実験を行う前に希ガスイオンや電子を照射し表面を クリーニングするのであるが、クリーニングの状況 によって、それぞれの実験において使われるター ゲットの表面の状態がかなり異なるのではないかと 考えられる。今回の解析ではフラクタル次元を2.1 にした場合に実験データをよく再現できることか ら、表面の凹凸がフラクタル次元2.1に近い形状を していたのではないかと考えられる。本研究によっ て、表面の凹凸がスパッタリングに寄与しているこ とがわかる。固体表面の凹凸は表面近傍の密度を小 さくする働きをするために、それに伴ってスパッタ リング収量が減少することが明らかにされた。

参考文献

- 1) Y. Yamamura and Y. Mizuno, IPPJ-AM-40, Inst. Plasma Physics Nagoya Univ. (1985).
- 2) M. A. Shaheen and D. N. Ruzic, J. Vac. Sci. Technol. A 11, 3085 (1993)
- 3) M.F. Barnsley, R.L. Devaney, B.B. Mandelbrot, H.O. Peitgen, D. Saupe and R.F. Voss, in : The Science of Fractal Images, Springer–Verlag, New York, 1988.
- 4) M. A. Karolewski, Radiat. Eff. 153, 239 (2001).
- 5) H. L. Bay and J. Bohdansky, Appl. Phys. 19, 421 (1979).
- 6) T. Kenmotsu et al., Nucl. Instr. and Meth. B228, 369 (2005)